









	<h2 style="color: red;">IPB039N10N3GE8187ATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB039N10N3GE8187ATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 160A TO263-7
Datenblätter:	 IPB039N10N3GE8187ATMA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	IPB039N10N3GE8187ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 160A TO263-7
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 160µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-7
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.9 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	214W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D²Pak (6 Leads + Tab), TO-263CB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8410pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	117nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	160A (Tc)

IPB039N10N3GE8187ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB039N10N3GE8187ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB039N10N3GE8187ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB039N10N3GE8187ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  IPB03N03LA Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 80A D2PAK	 IPB03N03LA G Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 80A TO-263	 IPB03N03LAG VB IPB03N03LAG VB	 IPB039N10N3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 160A TO263-7
 IPB03N03LB Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK	 IPB039N10N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 160A TO263-7	 IPB03N03LB G Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 80A TO-263	 IPB039N10N3G INFINEO IPB039N10N3G INFINEO

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB039N10N3GE8187ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB039N10N3GE8187ATMA1 Datenblatt	IPB039N10N3GE8187ATMA1- Datenblätter	IPB039N10N3GE8187ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB039N10N3GE8187ATMA1
IPB039N10N3GE8187ATMA1 Electronic	IPB039N10N3GE8187ATMA1- Komponenten	IPB039N10N3GE8187ATMA1-Verteiler	IPB039N10N3GE8187ATMA1-Bild	IPB039N10N3GE8187ATMA1-Teil
IPB039N10N3GE8187ATMA1 Aktie	IPB039N10N3GE8187ATMA1 Inventar	IPB039N10N3GE8187ATMA1 Neu	IPB039N10N3GE8187ATMA1 Hersteller	IPB039N10N3GE8187ATMA1 Bild
IPB039N10N3GE8187ATMA1 RFQ	IPB039N10N3GE8187ATMA1 Online bestellen		IPB039N10N3GE8187ATMA1 Original	IPB039N10N3GE8187ATMA1 garantiert